В области значений потребляемой мощности 150–200 мВ наблюдаются более высокие выходные сигналы для сенсоров, у которых чувствительный элемент изготовлен из оксидной композиции, полученной с ультразвуковым воздействием. При этом при потребляемой мощности 200 мВт увеличение выходного сигнала превысило 20 %.

Выходной сигнал сенсоров может увеличиваться за счет усиления структурного разупорядочения оксидной композиции при ультразвуковом воздействии, а также за счет возрастания удельной поверхности в результате снижения размеров кристаллитов и изменения морфологии частиц. По данным ренгенофазового анализа, при термической обработке ксерогеля, полученного из совмещённых золей гидрооксидов индия и галлия, в интервале 300-600 °С (2 ч) образуется твёрдый раствор (Ga,In)2O3 на основе кубической структуры оксида индия C-In₂O₃. Образцы композиции In₂O₃-Ga₂O₃ (отжиг 300 °C, 2 ч), полученные в сопровождении ультразвукового воздействия, имели размеры областей когерентного рассеяния, значения которых принято отождествлять с физическими размерами кристаллитов, ОКР = 12 нм, а в отсутствии ультразвукового воздействия – ОКР = 20 нм (параметр кристаллической решётки составил в обоих случаях *а*=10,12 Å ± 0,04).

Ультразвуковой синтез оксидов вольфрама (WO₃) и индия (In₂O₃), а также твёрдого раствора (Ga,In)₂O₃, является эффективным способом получения нанодисперсных поликристаллических материалов.

Ультразвуковое сопровождение в процессе золь-гель синтеза позволяет получить материалы с большей удельной поверхностью и меньшим эквивалентным диаметром частиц, что изменяет ширину запрещённой зоны и энергию активации проводимости. Такие изменения приводят к росту газовой чувствительности и снижением рабочей температуры датчиков.

Литература

1. Malchenko, S.N. One-electrode semiconductor sensors for detection of toxic and explosive gases in air / S.N. Malchenko, I.N. Lychkovsky, M.V. Baykov // Sens. and Actuators B. Chem. – 1992. – Vol. 7. – Issue 1–3. – P. 505–506.

2. Korotchenkov, G. Practical aspects in design of one-electrode semiconductor gas sensors: Status report / G. Korotchenkov // Sens. and Actuators B. Chem. – 2007. – Vol. 121. – P. 664–678.

3. Гайдук, Ю.С. Полупроводниковые датчики диоксида азота на основе композиции In₂O₃-Ga₂O₃-WO₃ / Ю.С. Гайдук, А.А. Савицкий, В.А. Ломоносов // Известия НАНБ. Серия хим. наук, 2018. – Т. 54, № 2. – С. 146–153.

УДК 535.317

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСС СИНТЕЗА ОРТОФЕРРИТА ВИСМУТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

Головач Р.В.¹, Дятлова Е.М.¹, Сергиевич О.А.¹, Шеченок А.А.², Шамкалович В.И.³

¹Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» ²Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» ³Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь

Потребность в нанокомпозитных материалах обусловлена необходимостью разработки новых методов получения интеллектуальных функциональных наноматериалов для приборов автоматики, сенсоров и других устройств микроэлектроники. Важнейшими требованиями к подобным материалам являются высокие эксплуатационные характеристики, простота и надежность синтеза и использования, универсальность, позволяющая как сочетать данные материалы с различными видами подложек, так и возможность использовать их как индивидуальное изделие, а также экономичность и низкое энергопотребление. В этой связи большое внимание уделяется разработке новых видов керамических наноматериалов, а именно макропористых композитов, отвечающих всем заявленным требованиям [1].

На основании вышеизложенного сформировалось основное направление исследований и цель работы, заключающаяся в разработке составов и технологических параметрах синтеза сегнетокерамических наноматериалов и получение функциональных покрытий, в т. ч. нанокомпозитов для интегрированных исполнительных элементов приборов и устройств автоматики.

Синтез модифицированного ортоферрита висмута проводился двумя методами: высокотемпературным спеканием порошков и химическим, обеспечивающим экзотермическую реакцию в растворах компонентов. В качестве исходных материалов для синтеза ортоферрита висмута традиционным методом спекания использовались оксиды Bi₂O₃, Fe₂O₃, в качестве модифицирующих добавок – La₂O₃, Ce₂O₃ и Co₃O₄, которые вводились в количестве 0,1– 0,2 мол. долей. В зависимости от вида добавки образцы обжигались при температурах 800– 925 °C.

По второму способу получение мультиферроиков проводилось с использованием энер-

гоэффективного нитрат-цитратного метода синтеза, который включает приготовление водного раствора, содержащего нитраты металлов и лимонную кислоту, и термическую обработку этого раствора. При нагревании до 60 °C раствор трансформируется в гель, при 95 °C происходит разложение нитрат-цитратного раствора. Полученные порошки прокаливались при 450 °C и измельчались. Отпрессованные и высушенные образцы подвергались повторному спеканию при 800 °C со скоростью подъема температуры 10 °C/мин с выдержкой при максимальной температуре в течение 30 мин.

На первом этапе было исследовано влияние модифицирующих добавок при синтезе ортоферрита висмута. Зависимость среднего значения водопоглощения опытных образцов от количества модификатора, обожженных при температурах 850 и 900 °C приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Зависимость водопоглощения образцов с различным содержанием модификатора, обожженных при температуре 900 °C (с La₂O₃ и Ce₂O₃) и 850 °C (с Co₃O₄)

Как видно из рисунка 1, водопоглощение образцов с минерализатором в количестве 0,1 мол. доли возрастает, а далее при повышении до 0,2 мол. доли уменьшается, что связано с их активизирующим действием, при этом минимальным водопоглощением (1,94 %) обладают образцы с добавкой Ce_2O_3 .



Рисунок 2 – Логарифмическая зависимость удельного сопротивления образца с добавкой Се₂О₃ (0,2 мол. доли) от температуры измерения

Электрическая проводимость является одной из важнейших характеристик синтезируемых материалов. Сопротивление полупроводников с ростом температуры уменьшается, проводимость увеличивается по причине того, что с ростом температуры в полупроводнике увеличивается число свободных электронов и «дырок» [2]. Графическая зависимость удельного объемного электрического сопротивления образца с оптимальной церийсодержащей добавкой от температуры измерения показана на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, удельное объемное электрическое сопротивление для исследуемых образцов равномерно уменьшается с увеличением температуры, что обусловлено зависимостью электропроводимости материала от концентрации носителей заряда, их величины и подвижности. Исследуемые материалы имеют ионы в узлах кристаллической решетки с невысокой подвижностью (отсутствуют ионы щелочных металлов). С ростом температуры увеличивается амплитуда и частота колебаний ионов в узлах кристаллической решетки, в результате чего повышается электропроводимость материала. Для обычных диэлектриков лагорифмическая зависимость электросопротивления линейная, однако, для сегнетоэлектрических материалов на кривых имеются перегибы, что обусловлено трансформацией их структур.

При синтезе ортоферрита висмута нитратцитратным методом в результате экзотермических реакций образуются нано- и микродисперсные частицы, которые однако образуют между более или менее прочные агрегаты. Для диспергации агрегатов были использованы прокаливание проб, растирание ручное и механическое в агатовой ступке и планетарной мельнице. Для исследования дисперсности синтезированных материалов использовался метод лазерной гранулометрии (рисунок 3).



Рисунок 3 – Дифференциальная и интегральная кривые распределения частиц по размерам синтезированного ортоферрита висмута (а), подвергнутого прокаливанию (б), с первичной диспергацией и растиранием в агатовой ступке (в), подвергнутого прокаливанию и помолу в планетарной мельнице (г)

На основании данных рисунка 3 видно, что агрегаты синтезированного материала имеют размеры от 30 до 250 мкм. Прокаливание приводит к распаду агрегатов и выделению частиц в нанодисперсном диапазоне (менее 0,15 мкм): значительно уменьшается максимальный размер частиц (менее 150 мкм), и агрегаты представлены в основном тремя фракциями. Растирание в агатовой ступке приводит к изменению дифференциальной кривой распределения и увеличению количества частиц с размером от 10 до 50 мкм. Более эффективна диспергация агрегатов в планетарной мельнице: максимальный размер частиц не превышает 10 мкм, значительно увеличивается содержание частиц менее 5 мкм и нанодисперсного диапазона.

Установлены закономерности изменения свойств синтезированных образцов в зависимости от вида и количества модификаторов. Синтезированы и исследованы керамические материалы на основе феррита висмута с использованием модифицирующей добавки Ce₂O₃ в количестве 0,1 мол. доли методами традиционного спекания и химическим синтезом. Получены функциональные керамические покрытия на микропористых подложках с использованием различных вариантов подготовки исходной керамической субстанции необходимого микро- и нанодисперсного диапазона. При разных методах их нанесения разработанные материалы могут использоваться для изготовления различных компонентов электронной техники [3], в т. ч. для функциональных покрытий микропористых структур, используемых для изготовления средств автоматизации и автоматики.

Литература

1. Макоед, И.И. Получение и физические свойства мультиферроиков: монография / И.И. Макоед; Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2009. – 181 с.

2. Бабич, В.М. Технология производства ферритов и радиокерамики: учеб. пособие для втузов / В.М. Бабич. – М. : Высшая школа, 1984. – 223 с.

3. Магнитная керамика на основе модифицированного феррита висмута / Р.В. Головач, О.А. Сергиевич, Ю.С. Шинелько, Е.М. Дятлова // 71-я Всерос. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием: сб. материалов конф., Ярославль, 18 апр. 2018 г. в 3 ч. [Электр. ресурс]. – Ярославль : Издат. дом ЯГТУ, 2018. – Ч. 1. – С. 100–103.

УДК 539.2:669.(1-8)

МИКРОСТРУ́КТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ ОЛОВО–СВИНЕЦ, ПОЛУЧЕННОГО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ЗАТВЕРДЕВАНИЕМ

Гольцев М.В.¹, Белая О.Н.¹, Иванов А.А.¹, Шепелевич В.Г.², Гусакова С.В.²

¹Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь ²Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

Сплавы на основе системы олово-свинец характеризуются высокими технологическими параметрами и используются в различных отраслях промышленности. На их основе изготавливаются легкоплавкие припои, подшипниковые сплавы, сплавы для кабельных оболочек, элементы электрических цепей и др. В последние десятилетия успешно развиваются нетрадиционные технологии получения материалов, к которым относится и высокоскоростное затвердевание расплава, позволяющее достичь скоростей охлаждения выше 10⁵ [1]. Структура сплавов, получаемых при сверхвысоких скоростях охлаждения, отличается от структуры, образующей в сплавах при малых и средних скоростях охлаждения. В связи с этим является актуальным исследование структуры и физических свойств сплавов системы олово-свинец, используемых в промышленности, например, эвтектического сплава.

Эвтектический сплав (Sn – 27 ат. % Pb) изготовлен сплавлением компонентов в кварцевой ампуле. Расплав сначала заливался в графитовую изложницу и затвердевал в форме стержня длиной 10 см и поперечным сечением 3×5 мм². Кусочек сплава массой ~ 0,15 г расплавляли и инжектировали на внутреннюю полированную поверхность быстроврашаюшегося медного цилиндра. Расплав растекался тонким слоем на поверхности кристаллизатора и затвердевал в виде фольги длиной до 10 см и шириной до 10 мм [1]. При исследовании использовались фольги толщиной 30 ... 100 мкм. Исследование микроструктуры фольг быстрозатвердевшего сплава выполнено на растровом электронном микроскопе LEO-1455 VP (Германия) с рентгеноспектральным микроанализатором Aztec Energy Advanced X-Max80 (Великобритания), позволяющим определить элементный состав и распределение компонентов, а также с дифракционной приставкой фазового анализа НКL EBSD Premium System Channel 5 (Великобритания), благодаря которой исследована зеренная структура фольг. Для определения фазового состава и текстуры применялся рентгеноструктурные исследования, проводимые на дифрактометре ДРОН-4. Полюсная плотность дифракционных линий рассчитывалась по методу Харриса [2]. Исследование микроструктуры проводилось со стороны А фольги, контактирующей с кристал-